



# تاثیر عوامل فر آیندی بر ریزساختار بدنه تهیه شده به روش رسوبنشانی الکتروفور تیک از ذرات نانو آلومینا

مصطفى ميلاني'، سيد محمد مير كاظمى ً و سيد محمد زهرايي\*'

۱- پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژیهای نو، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
 ۲- دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

تاريخ ثبت اوليه: ١٣٩٥/٥٩/٢٥، تاريخ دريافت نسخه اصلاح شده: ١٣٩٥/١٠/٢٨، تاريخ پذيرش قطعي: ١٣٩٥/١٢/١١

#### چکیدہ

کنترل اندازه تخلخل و همگن بودن ریز ساختار قطعه خام اولیه در ساخت بدنه های سرامیکی از مهمترین چالش های تکنیکی در تولید این قطعات می باشد. در این تحقیق برای ساخت یک بدنه همگن سرامیکی از جنس آلومینا از روش رسوب نشانی الکتروفور تیک نانوذرات آلومینا بهره گرفته شد. سوسپانسیون اولیه در محیط اتانول تهیه شد و با استفاده از اولتر اسونیک پر اب کلو خه زدایی شد و در زمان های طولانی (تا ۹۰ min ممزده شد تا یک فر آیند پیرسازی انجام گیرد. قطعه خام اولیه در پتانسیل الکتریکی ۵۰ تا ۷۰۸ و فاصله الکترود ۱ و ۲۰ تهیه شد. بدنه آلومینایی بدست آمده به وسیله تخلخل سنجی فشار جیوه، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (EESEM) و طیف سنجی مرئی بدنه آلومینایی بدست آمده به وسیله تخلخل سنجی فشار جیوه، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (Hesser) و طیف سنجی مرئی UV-Vis مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تاثیر فر آیند کلوخهزدایی با بررسی خواص رئولوژی سوسپانسیون های تهیه شده، مورد از یابی قرار گرفت. در بهترین شرایط، اندازه متوسط تخلخل نمونه خام (ds) بر ابر با ۳۰ ۵۳ بدست آمد. همچنین مشخص گردید اندازه تخلخل در این نمونه ها طی فر آیند کلوخهزدایی سوسپانسیون (عار ۱۹۰۱ اولتر اسونیک و ۱۳۰۰ بدست آمد. همچنین مشخص گردید اندازه تخلخل در مناسب (۷ ۵۰ مه می از گرفت. همچنین با توجه به نتایج آنالیز UV-Vا ما میل میدانی پر اکتریکی و فاصله الکترود مناسب (۵ مه می ای از می اسوسپانسیون (عار اولتر اسونیک و ۱۳۰۰ بیر سازی) و اختلاف پتانسیل الکتریکی و فاصله الکترود و مورد پیوندهای OH سطحی در حضور ید است که با افزایش زمان پیر سازی افزایش می یابد.

*واژههای کلیدی*: بدنه آلومینای نانوساختار، EPD، رئولوژی، شدت میدان الکتریکی، اولتراسونیک.

#### ا\_ مقدمه

دو فاکتور به عنوان مشکلات پیش روی تهیه بدنههای آلومینایی نانوساختار مطرح است: اول اینکه دستیابی به

نانوپودر آلومینا با توزیع باریک اندازه ذرات و آگلومرههای غیر سخت مشکل است (با اندازه ذره کمتر از ۲۰ nm) [۳–۱] و دوم تف جوشی مرحله نهایی همواره با رشد سریع دانه روبرو است [۶–۴]. از آنجائیکه پودرهای نانو با اندازه

**نشانی:** تهران، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژیهای نو

تلفن: ۵۶۲۷۶۶۳۵-۲۱۰، دورنگار: ۵۶۲۷۶۶۳۵-۲۱۰، پست الکترونیکی: smzahraee@irost.org

<sup>\*</sup> **عهدەدار مكاتبات:** سيد محمد زهرايي

ذرات کمتر از ۱۰۰ سایل به آگلومره شدن دارند، شرایط مناسب برای یکنواخت تر شدن قطعه نهایی، توزیع تخلخل مناسب، در قطعه شکل دهی شده است. از این رو قطعات خام باید همگنی مناسبی داشته باشند و این از طریق دوغابهای با محتوای جامد بالا و پراکنده سازی مناسب حاصل می گردد. چنین بدنه هایی در دماهای تف جوشی کمتر، منجر به اندازه دانه های کوچکتر نیز شده اند (در چگالی ۹۹/۹۷٪) [۷].

مطالعات کرل و همکارانش [۸] نشان می دهد که با بهینه کردن شرایط تکنیکی (که برای پودرهای مختلف متفاوت است) پودرهای نانومتری دارای نسبت نزدیک تری در «اندازه ذرات پودر مواد اولیه به اندازه نهایی دانه در ریزساختار بدنه» است. برای رسیدن به چگالی مشابه با استفاده از ذرات نانومتری اندازه دانه کوچکتری نسبت به ذرات میکرومتری بدست می آید.

نکته دیگر قابل ذکر در مورد پودرهای با اندازه ذرات زیر میکرونی است که قطعات تهیه شده از این پودرها در حین تص جوشی انقباض های بسیار بیشتری دارند. بنابراین فرآیندهای شکل دهی، به نحوی که بتواند، میزان آسیب های بعد از تف جوشی را به حداقل برساند، یک امر اساسی در شکل دهی یک بدنه سرامیکی با چگالی بالا است. از این رو این چالش همچنان یکی از مواردی است که در زمینه بهبود بخشیدن به خواص بدنه آلومینایی مورد مطالعه قرار می گیرد. اگر چه همچنان که گزارش گردیده است، تخلخلی در حدود ۳/۰ تا ۵/۰ درصد می تواند بالاترین سختی را در یک قطعه کوراندومی تف جوشی شده با اندازه دانه های زیرمیکرونی ایجاد کند [۹].

در هر روش شکل دهی، تخلخل بین آگلومره ها در حد و اندازه، آگلومره ها است [۱۰،۱۱]. این موضوع بیانگر این است که در شکل دهی اولیه علاوه بر انتظارات معمول از روش شکل دهی باید این انتظار را هم داشت که روش شکل دهی نه تنها سبب افزایش میزان آگلومره های بین پودری نشده بلکه بتواند آنها را کاهش نیز دهد. روش

شکلدهی می تواند در کاهش مقدار کلوخههای موجود در بدنه خام موثر باشد.

اهمیت کنترل اندازه و توزیع اندازه تخلخل ها در مرحله تفجوشي نهايي مشخص مي شود. براي حذف تخلخل ها در مرحله تفجوشي لازم است تخلخل هاي قطعه خام در حدى باشند که از نظر ترمودینامیکی با رشد دانه ها حذف گردند [۱۲،۱۳]. در روش های شکل دهی که از فشار پرس استفاده می کنند، مانند پرس ایزواستاتیک سرد و یا پرس هم محور گرم، عموما توزيع تخلخل ها غيريكنواخت است. برخلاف این روشها در روشهای شکلدهی تر نظیر رسوبنشانی الكتروفورتيك، ذرات در قطعه خام چينش همگن تري خواهند داشت [۸]. در این روش های شکل دهی با تنظیم دقیق فرآيند مي توان به قطعات خام با چگالي هاي خيلي بالا دست یافت تا رشد دانه در مرحله تفجوشی هم تضمین گردد. عدم رشد دانه سبب افزایش استحکام مکانیکی بدنه بعد از تفجوشي خواهد شد. بر اساس تحقيقات صورت گرفته حتبی در نمونه های با چگالی خام بالا، در روش های شكل دهي با پرس تخلخل هاي بزرگ علي رغم چگالش کامل، بعد از تفجوشي حذف نمي شوند [٨].

یکی از روش های شکل دهی تر که در بدنه خام نهایی توزیع مناسبی از تخلخل ها را ایجاد می کند، روش رسوب نشانی الکتروفور تیک است که در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است و تولید قطعات صنعتی با استفاده از این روش توسعه یافته است [۱۴،۱۵]. پارامتر های زیادی در این روش شکل دهی موثر هستند که منجر به تغییر چگالی و توزیع اندازه تخلخل نمونه های بدست آمده می گردد (۱۶،۱۷]. ریز ساختار بدنه های خام که از روش رسوب نشانی روش های شکل دهی بدست می آید با قطعه ای که از سایر تفاوت اساسی است. قابلیت تف جوشی قطعاتی که به روش الکتروفور تیک شکل داده شده اند با رعایت برخی از جزئیات بسیار عالی است زیرا اندازه تخلخل های موجود در

همانطور که در مطالعه ژانگ و همکارانش [۱۹] روی آلومینا گزارش شده ساختار سل الکتروفورتیک بر چگالی خام تاثیر داشته و این تاثیر بعد از تفجوشی منجر به اختلاف اساسی در چگالی نسبی شده است و بالاترین چگالی بدنه خام و بعد از تفجوشی مربوط به حالتی است که در آن الکترودها افقی قرار بگیرند و رسوب در الکترود بالایی تشکیل شود و همچنین محلول همزده نشود و چگالی نهایی قطعه تفجوشی شده به بیش از ۹/۹۹٪ چگالی تئوری رسیده است. در صورتی که چگالی بقیه نمونه ها کمتر از ۸۹٪ چگالی تئوری است. در این تحقیق تاثیر زمان و روش کلوخهزدایی و زمان

پیرسازی در ساخت سوسپانسیون و تاثیر آنها بـر ریزسـاختار بدنــه خــام شــکل داده شــده بــه روش رســوبنشــانی الکتروفورتیک بررسی شده است.

## ۲- فعالیتهای تجربی

به منظور تهیه سوسیانسیون از نانوپودر کوراندوم با اندازه متوسط ذرات ٨٠ نـانومترو خلـوص بـالايي ٩٩/٩٥٪ (US Nano Research, US 3008) استفاده شد. سوسیانسیون ها با اضافه کردن ید (Merck Millipore, 99.9%)، نمکهای کلریدی آبدار منیزیم، ایتریم و لانتانیم sigma Aldrich, 99.99%, MCl<sub>v</sub>.nH<sub>2</sub>O ) بطور همزمان ( و سيس (M: Mg, Y, La; y: 2 and 3, n: 4 and 6) نانوپودر آلومینا به حجم ۶۷ mL اتانول (ساخت شرکت Merck Millipore, 99.5%) در مدت زمان ۱۰ تهیه گردید. مقادیر نمکها در تمام سوسپانسیون ها ثابت و به ترتيب ۳۰۰، ۴۵۰ و ۲۰۰ واحد به ازای میلیون واحد آلومينا (ppm) در نظر گرفته شد. بعد از ساخت سوسپانسیون یک مرحله کلوخهزدایی و همگن سازی به ترتیب با استفاده از اولتراسونیک پرابی و همزن مغناطیسی انجام گرفت. برای استفاده از اولتراسونیک پرابی از سیکل های ۲ به ۱۰ استفاده شد به این ترتیب که ۲ ۶ زمان روشن بودن و ۱۰ ۶ زمان استراحت بود. با استفاده از این روش تغییرات دمای محلول

از ابتدا تا انتهای فرآیند از C° ۱ بالاتر نرفت. در اینجا کل زمان روشن بودن به عنوان زمان اولتراسونیک گزارش شد و زمان های استراحت در نظر گرفته نشده است. سوسپانسیونهای کلوخهزدایی شده با فرآیند اولتراسونیک با علامت U در انتهای کد نمونه مشخص شدند.

فرآیند رسوب نشانی در اختلاف پتانسیل الکتریکی مورد نظر (۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۷ ۸۰) و فاصله بین الکترودهای مشخص (۱ و ۲ ۲۳) در مدت زمان ۲ ۱۸۰۰ انجام گرفت. در هر آزمون سوسپانسیون قبل از انجام فرآیند تهیه شد. شرایط ساخت سوسپانسیون ها و رسوب نشانی در جدول ۱ آمده است. الکترودهای مورد استفاده از جنس فولاد زنگ نزن و تیتانیم به ترتیب به عنوان آند و کاتد بود که قبل از هر مرحله رسوب نشانی با دقت به وسیله اسید نیتریک، آب یون زدایی شده و استون شسته شدند. الکترود محل رسوب (الکترودی که ذرات معلق در سوسپانسیون بر آن رسوب می نماید) قبل و بعد از فرآیند رسوب نشانی با دقت توزین شد تا وزن رسوب بدست آمده مشخص گردد.

## ۳- نتايج و بحث

شکل ۱ توزیع تخلخل در نمونههای رسوب داده شده در

مقدار بار جامد (g/lit)	عمليات ساخت سوسپانسيون	فاصله الكترودها	پتانسیل اعمالی	کد
		(cm)	(V)	نمونه
١٥	بدون کلوخهزدایی، ۹۰ min همزن مغناطیسی، ۴۰۰ ppm ید	١	٨٠	۸۰۱
		١	٧٠	۷۰۱
		١	۶.	۶۰۱
		١	۵۰	0.1
		۲	۵۰	۵۰۲
۱۵	۱۲۰ کلوخهزدایی با اولتراسونیک و ۹۰ min پیرسازی، ۴۰۰ ppm	١	٧.	۷۰۱U
		١	۶.	9• 1U
		١	۵۰	۵۰۱Ս
۱.		١	۵۰	SLV
١٢		١	۵۰	SLIT
۱۵		١	۵۰	SL10
۱۸		١	۵۰	SLIA

جدول ۱: شرایط نمونه های مختلف در هنگام ساخت سوسپانسیون و فرآیند رسوبنشانی.

با سرعت بالا به الکترود میرسند فرصت کافی برای انتخاب بهترین مکان از نظر ترمودینامیکی را ندارند [۲۳–۲۰]. لذا در اثر سرعت بالایی که دارند با فشار بسیار زیاد به رسوب های قبلی اضافه شده و حفرات کوچکتری نسبت به حالت تعادلی ایجاد می کنند.

در میدان الکتریکی ۷۰ ۷/cm هر چند میزان تخلخلهای نانومتری کم شده است اما تخلخلهای بزرگتر از ۳۸ ۳۸ هنوز به مقدار زیاد وجود دارند و همچنین بازه تخلخل در اطراف <sub>50</sub> هنوز محدوده وسیعی را در برمی گیرد. اگرچه این بازه باید باریک تر باشد اما قسمت مهمتر اندازه تخلخلهای بزرگ موجود می باشد که باید حذف گردد. در میدان الکتریکی ۵۰ و ۷/cm ۶۰ مهمترین اتفاق حذف تخلخلهای بزرگ است. با حذف شدن این تخلخلها مشخص می شود که در میدانهای الکتریکی کمتر از شده و ترکهای ایجاد شده در اثر سرعت بالای ذرات بوجود نمی آیند. همچنین در این دو نمونه اندازه متوسط تخلخل برابر با ۳۹۰ ۳ و در محدوده باریکی قرار گرفته است. یعنی نظم در رسیدن ذرات بیشتر شده و ذرات از نظر ترمودینامیکی بهترین محل برای رسوب را انتخاب می کنند. میدان های الکتریکی مختلف را نشان میدهد. در میدان الكتريكي E =۸۰ V) ۸۰ V/cm و d =۱ cm الكتريكي نمونه به گونهای است که تخلخل های بسیار ریز در حجم بالايي مشاهده مي شود و همچنين ميزان تخلخل در اندازه های بالاتر از ۲۵۰ nm و بیشتر هم بسیار بالاست. همانطور که در مقدمه توضیح داده شد این قسمت از نمودار توزيع تخلخل در مورد نمونه هايي كه به منظور ساخت نمونه های با چگالی بالا (۹۹/۹۹٪) مورد استفاده قرار مي گيرند، بسيار مهم ميباشد [٧]. وجود حجم بالايي از تخلخل های بزرگ نشان می دهد که شدت میدان زیاد ایجاد شده سبب اغتشاش بالا و سرعت بالای ذرات در هنگام رسیدن به سطح قطعه شده که با تکانهای که ایجاد می کنند سبب تخريب رسوب شده و مي توانند در آن ترک ايجاد کنند. با توجه به گزارش های محققان تخلخل های زیر ۱۰ nm هم به دو دلیل ایجاد می شود. اولین دلیل وجود این تخلخلها در آگلومرههای موجود در پودر است. اگر پودر اوليه در مراحل كلوخهزدايي به خوبي يراكنده نشده و آگلومره های موجود در پودر به سوسپانسیون منتقل شوند این تخلخل ها در قطعه نهایی نیز باقی خواهند ماند [۷]. دلیل دوم سرعت بالای ذرات در هنگام رسوب است. وقتی ذرات

R

این محل بهینه، در فرآیند الکتروفورتیک، محلی است که مقاومت الکتریکی کمتری دارد [۲۴]. همین سرعت مطلوب ذرات در هنگام رسیدن به سطح الکترود سبب شده است که تخلخل های بسیار ریز نیز حجم کمتری داشته باشند. تخلخل های ریز باقیمانده در نمونه بدلیل عدم تخریب آگلومره های پودر مورد استفاده در فرآیند کلوخهزدایی است. اندازه متوسط تخلخل در نمونه ۲۰۰، ۶۰۱ نانومتر و در نمونه نیز به ترتیب ۸/۸۱ و ۳۲/۴ m<sup>2</sup>/۳ است. بنابراین می توان نمونه نیز به ترتیب ۱۸/۸ و ۵/۴ ست. می بهتر از نمونه ۶۰۱ ادعا نمود که شرایط تهیه نمونه ۵۰۱ کمی بهتر از نمونه ۶۰۱ بوده است.

شکل ۲ آگلومره ها در پودر آلومینای مورد استفاده را نشان میدهد. هر چند آگلومره های درشتی در نمونه دیده می شود اما به نظر میرسد این آگلومره ها تحت فرآیندهای کلوخهزدایی قابل حذف باشد.

برای بررسی بیشتر، نمونه ۵۰۲ نیز تحت آزمون تخلخل سنجي قرار گرفت. همانطور که مشخص است شرایط تخلخل های ریز این نمونه به شرایط تخلخل های نمونه ۸۰۱ نزدیک شده است. اما تخلخل های درشت که در اثر سرعت بالا ايجاد مي شوند وجود ندارنـد. لـذا كـاهش میدان الکتریکی کمتر از ۵۰ V/cm و یا به عبارتی تغییر فاصله الكترودها از ۱ به ۲ cm، بیشتر در ناحیه تخلخل های ریز این نمونه به شرایط تخلخل های نمونه ۸۰۱ نزدیک شده است. اما تخلخل های درشت که در اثر سرعت بالا ایجاد مي شوند وجود ندارند. لذا كاهش ميدان الكتريكي كمتر از ۵۰ V/cm و يا به عبارتي تغيير فاصله الكترودها از ۱ به ۲ cm، بیشتر در ناحیه تخلخل های ریز تاثیر گذار است. این موضوع تاییدی بر این ادعا است که تخلخل های بزرگ ایجاد شده در نمونه ۸۰۱ و ۷۰۱ (بخش انتهایی نمودار توزیع تخلخل) مربوط به سرعت بالای ذرات در این میدان الکتریکی قوی است. اما تخلخل های ریز بوجود آمده در نمونه ۵۰۲ می تواند مربوط به سینتیک کند فر آیند رسوب در این نمونه باشد. وزن رسوب نهایی در این نمونه حتی بعد از



شکل ۱: توزیع تخلخل در نمونههای ۸۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱، ۵۰۱ و ۵۰۲.



شکل ۲: تصویر آ<sup>-</sup>گلومرهها در نمونه نانوپودر آلومینا US3008.

مدت زمان ۲۸۰۰ نیز بسیار کم است (g ۲/۷۶) و این وزن رسوب کم سبب شده تخلخل های بسیار ریز هنوز وجود داشته باشند و حجم زیادی از تخلخل کل را به خود اختصاص دهند. در صورتی که در نمونه ۷۰۱ این مقدار g ۴/۱۲ است. لذا بدلیل میزان کم وزن رسوب در آزمایش های بعدی از فاصله ۲ صرفنظر شد.

نکتهای که در این نمونهها وجود دارد اندازه متوسط تخلخل است که در همه نمونهها (به غیر از ۸۰۱) بالاتر از ۲۶۰ nm است. در صورتی که اندازه پودر استفاده شده ۸۰ nm بوده و

در بدترین حالت باید اندازه تخلخل نمونه نهایی در محدوده اندازه ذرات پودر باشد که البته هدف مطلوب رسیدن به عددی در محدوده ۴۰ nm یعنی نصف اندازه ذرات است [۷]. لذا با همین هدف فرآیند کلوخهزدایی پودرها بهینهسازی شد.

براي كلوخهزدايمي از فرآيند اولتراسونيك پرابي كمك گرفته شد. از نظر تئوري يک کلوخهزدايي خوب زماني اتفاق مىافتدكه اولا ويسكوزيته دوغاب حاصل پايين باشد و ثانيا دوغاب رفتاري نيوتني يا شبهنيوتني داشته باشد [١٩،٢٥]. لذا رفتار رئولوژي دوغاب جهت بررسي ميزان تـاثير فرآينـد کلوخهزدایی در نظر گرفته شد. شکل ۳ تغییرات ویسکوزیته سوسیانسیون را در زمان های مختلف کلو خهزدایی نشان مى دهد. اعداد نشان داده شده در تصوير زمان خالص روشن بودن اولتراسونیک میباشد. زمانی که سوسپانسیون ۴۰ s آگلومره زدایی میشود، هنوز دوغاب ویسکوزیته بالایی دارد ولي رفتاري شبهنيوتني دارد. با افرايش زمان کلوخهزدایی به s ۵۰ اندازه ویسکوزیته کمتر شده و شیب نمودار نيز تغيير قابل تـوجهي مـيكنـد. البتـه هنـوز رفتـار بـه حالت شبه یلاستیک کامل نرسیده است. با افزایش زمان تا ۱۱۰s ویسکوزیته دوغاب مرتبا کمتر شده و در نهایت به C/۷ cP می رسد. با افزایش زمان تا ۲۰۶ شدت تغییرات بسیار کم شده و عملا می توان گفت بالاتر از این زمان ويسكوزيته تغيير محسوسي نمي كند. شكل ٣-ب تغييرات ویسکوزیته بین ۹۰ تا ۱۲۰ دا با وضوح بیشتری نشان مى دھد.

در ادامه به منظور همگن سازی و تاثیر بهتر پراکنده ساز و به تعادل رسیدن برخی واکنش های شیمیایی در داخل محلول یک زمان جهت فر آیند پیرسازی در نظر گرفته شد. در طول ایسن مدت از یک همزن مغناطیسی استفاده گردید و ویسکوزیته دوغاب هر ۱۵ اندازه گیری شد. شکل تغییرات ویسکوزیته دوغاب را نشان می دهد. همانطور که مشخص است با ۱۵ اپیرسازی ویسکوزیته دوغاب به زیر عدد ۲۵ ۵/۵ رسیده است که در ۱۲۰ ثانیه اولتراسونیک این

عدد بالاتر از این مقدار بود. در ادامه هرچند تغییرات عدد ویسکوزیته شدید نیست اما روندی کاهشی را نشان میدهد و تا حدود ۳ cP رسیده است. در زمانهای بیشتر از ۹۰ min تغییرات زیاد نبود و لذا مدت زمان پیرسازی بیشتر از ادامه داده نشد و بهینه زمان پیرسازی ۹۰ min در نظر گرفته شد.

در نرخ برش های کم، رئولوژی سوسپانسیون به شدت تحت تاثیر اندازه ذرات و درصد وزنی آنها در سوسپانسیون است. به عبارت دیگر فاصله بین ذرات تعیین کننده است. در تمام نمودارها می توان برای سوسپانسیون یک تنش تسلیم (٦٥) در نظر گرفت (این تنش برشی در یک نرخ برش خاص معادل عدد ویسکوزیته ضربدر یک عدد ثابت است) که دلیل آن برهمکنش های شدید بین ذرات در اثر ریز بودن آنهاست. ایجاد تنش تسلیم مختص سوسپانسیون هایی با رفتار شبه پلاستیک است و در دو حالت دیده می شود. الف: در سوسپانسیون هایی با ضخامت لایه دو گانه خیلی زیاد و نیروی دافعه بزرگ

ب: در سوسپانسیون های حاوی ذرات آگلومره شده البته در سوسپانسیون های حاوی ذرات آگلومره شده، این تنش تسلیم در سوسپانسیون هایی به مراتب رقیق تر از سوسپانسیون های با لایه دو گانه ضخیم دیده می شود. عدد تنش تسلیم با افزایش پایدارسازی سوسپانسیون، در سوسپانسیون های حاوی ذرات پراکنده شده به وسیله نیروهای الکترواستاتیک (افزایش پتانسیل زتا) کاهش می یابد. ذرات ریز تر و بار جامد بالاتر باعث افزایش تنش تسلیم می شود که دلیل آن افزایش برهمکنش های بین ذرات است. همچنین کاهش میزان آگلومره شدن سبب می شود مقدار این تنش برشی کمتر شود [۲۶].

برای بررسی مکانیزم عمل کننده در زمان پیرسازی از نمونههای مختلف آزمون UV-Vis انجام گرفت. شکل ۵ نتایج بدست آمده را نشان میدهد. در طیف UV دو باند جـذبی در ۷۲ ۲۳/۵ (۲۳۷ nm) و ۶ ۶ (۲۰۶ nm) دیـده میشود. برخی محققین پیک ضعیف به وجود آمده در

mv ۲۳۷ را به ناخالصی ها نسبت داده اند [۱]. همچنین عیوب ذاتی یک باند جذبی در این ناحیه دارند (مراکز <sup>+</sup>F (اکسیژن ترکیب نشده (non-bridging oxygen hole centers)) یک باند جذب در mn ۲۳۵ دارند) [۲،۳]. اگر چه برخی محققان دیگر نیز آن را به انتقال بار از <sup>-2</sup>O به <sup>+3</sup> Al که برابر با تابش انتقالی الکترون ها از باند ظرفیت (2 O) به باند هدایت (Al 3d) است نسبت داده اند [۴]. دو مورد اخیر در فازهای انتقالی آلومینا مانند گاما آلومینا یا کاپا آلومینا مشاهده می شوند. اما ترکیبات «سطحی» آلومینای آلفا بدلیل ایجاد پیوندهای HO می توانند از چنین ساختارهایی پیروی کنند. لذا هر چقدر مقدار این پیوندها بیشتر شود جذب در این ناحیه کاهش می یابد [۳].

شدت و عمق در طول موج mn ۲۰۶ نشان می دهد که این جذب به شدت به زمان پیرسازی وابسته است. با افزایش زمان پیرسازی شدت آن کاهش می یابد. این اتفاق ممکن است به جهت وجود برخی باندهای همپوشان مانند گروههای OH و عیوب آنیونی (مراکز F) باشد [۵]. علاوه بر این یک باند جذبی در mn ۲۳۶ هم مشاهده می شود که مربوط به د(OH)ا است. در برخی نمونه ها باند جذب قرار گرفته در جذبی دیگر همپوشانی می کند و نهایتا منجر به مشاهده تنها یک پیک می شود.

بنابراین مشخصا زمان پیرسازی را می توان به میزان OH شکل گرفته در سطح نسبت داد. از آنجائیکه میزان ید محلول در اتانول مشخص کننده میزان تشکیل OH است، لذا پودر پیرسازی شده در محلول های اتانولی با درصدهای مختلف ید نیز با استفاده از این آزمون بررسی گردید. شکل ۶ نتایج بدست آمده را نشان می دهد. همچنین با افزایش مقدار ید شرایط مشابهی در میزان عبور در ناحیه مقدار ید شرایط مشابهی در میزان عبور در ناحیه یکسان (۵ min) افزایش مقدار ید سبب شده است مقدار یکسان (۵ min افزایش مقدار ید سبب شده است مقدار در ناحیه OH بیشتری در داخل اتانول تشکیل شده و در نهایت جذب در ناحیه ۲۰۶ mm



شکل ۳: ویسکوزیته سوسپانسیون حاوی ۱۸۰ g/lit آلومینا در زمانهای اولتراسونیک مختلف، الف) محدوده زمانی ٤٠ تا ۱۲۰ s و ب) محدوده زمانی ۹۰s تا ۱۲۰ برای مشخص شدن دقیق تر میزان تغییرات.





پیوندهای هیدراتی در اثر اضافه کردن ید می توانـد مکانیزم غالب در پراکندهسازی نانو آلومینا در محلـول اتـانول و یـد باشد [۲۷،۲۸].



شکل ۵: میزان عبور UV-Vis نمونههای پودر اولیه و پیرسازی شده در زمانهای ۱۵، ٤۵، ۲۵ و ۹۰ mi و غلظت ید ۱۰۰ ppm، برای تشخیص بهتر محدوده ۱۸۵ تا ۲٤٥ ml وضوح بالاتری نشان داده شده است.



پیرسازی شده در زمان ۱۵ min با مقادیر ید محلول در اتانول به میزان ۱۰۰، ۲۰۰ ۲۰۰ و ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ (به ترتیب با کد 11، 12، ۱4 و 16).

$$CH_3 - CH_2 - CH_2 - OH + I_2 \rightarrow CH_3 - CH_2 - CHO + 2HI \quad (1)$$

$$MCl_{x} + xHI \xrightarrow{I_{2}} M^{+x} + xHCl + xI^{-}$$
 (Y)

چنانچه ملاحظه می شود این واکنش یک واکنش تعادلی است و با افزایش میزان ید مقدار OH بیشتری تولید می شود. اما با توجه به نتایج وزن رسوب مقدار بهینه ید ۴۰۰ ppm انتخاب گردید.

همچنین تاثیر اولتراسونیک با استفاده از بررسی ریزساختار نمونه پودری نیز انجام گرفت (شکل ۷). در نمونه مورد نظر

R

آگلومره های درشت دیده نشد و ذرات نیز تغییر مورفولوژی نداده و به خوبی توزیع شدهانـد. ایـن خصوصیات نمایـانگر بهینه شدن فرآیند کلوخهزدایی بوده و تغییرات ویسکوزیته را تایید می کند.

با استفاده از سوسپانسیون بهینه شده، در ۱۲۰ عملیات اولتراسونیک و ۹۰ ۹۳ هم زدن با همزن مغناطیسی بار دیگر فرآیند رسوبنشانی در سه میدان الکتریکی ۵۰، ۶۰ و ۷۰ ولت بر سانتی متر و فاصله الکترودهای ۲ تکرار شد. پتانسیل ۷ ۸۰ به علت حجم بالای تخلخل های ریزی که ایجاد می کند و همچنین مقادیر زیاد تخلخل های درشت در این سری از آزمون ها استفاده نشد. همچنین با توجه به اینکه فاصله ۲ مین الکترودها سبب کاهش وزن رسوب شده، لذا این فاصله و بنابراین این فاصله نیز استفاده نگر دید.

نتایج تخلخل سنجی نمونه های بدست آمده در شکل ۸ نشان داده شده است. با بهینه کردن عملیات کلوخه زدایی، توزیع تخلخل در این سه میدان باعث دو تغییر قابل توجه شده است. اولا اندازه متوسط تخلخل ها کمتر از اندازه تخلخل ها در حالت سوسپانسیون کلوخه زدایی نشده است و به اندازه کمتر از mn ۱۰۱ رسیده است. ثانیا در این سه اندازه میدان اندازه متوسط تخلخل ها برخلاف حالت قبلی با یکدیگر متف اوت است و تاثیر اندازه میدان در اندازه متوسط تخلخل ها کاملا مشخص است. با کاهش اندازه میدان الکتریکی از ۵۰ به ۷۰ اندازه تخلخل ها از ۱۰۱ به mm رسیده که با توجه به اندازه متوسط ذرات پودر مورد استاده (۸۰ mm) عدد مطلوبی می باشد.

در نمونه ۵۰۱U تخلخل های بزرگتر از ۱۰۰ سنیز به شدت کاهش یافته است در حالی که در دو نمونه دیگر (برخلاف نمونه های کلوخهزدایی نشده) اندازه تخلخل ها بسیار بزرگ است. لذا به نظر می رسد فر آیند کلوخهزدایی سبب شده است که تحرک ذرات (بدلیل کهش یافتن اندازه آگلومره ها در داخل سوسپانسیون) افزایش یافته و ذرات در همان میدان الکتریکی سرعت بالاتری نسبت به حالت قبل پیدا کنند و همین امر سبب شده است که در هنگام رسیدن در نهایت توزیع تخل شکل ۹ نشان داده تخلخلهای بزرگت رسوب داده شده د دیده نمی شود. د تخلخلها بزرگتر ش تخلخلها بزرگتر ش تخلخل کاهش یافته است. با افزایش بار -است. اما با افزایش

شکل ۷: تصویر پودر کلوخهزدایی شده بعد از ۱۲۰ ثانیه اولتراسونیک.



شکل ۸: توزیع تخلخل در نمونههای ۲۰۱، ۲۰۱ و ۵۰۱ بعد از بهینهسازی زمان اولتراسونیک و پیرسازی در بار جامد ۱۵ گرم آلومینا در ۱۰۰ میلی لیتر اتانول.

به سطح رسوب قبلی آسیب هایی را در آن ایجاد کرده و تخلخل های بزرگتری ایجاد کنند. در نتیجه بهترین اندازه میدان در حالت کلوخهزدایی سوسپانسیون، ۵۰ V/cm در نظر گرفته شد.

جهت بررسی تاثیر غلظت سوسپانسیون نیز چهار سوسپانسیون با غلظتهای مختلف تهیه شد و بر اساس فرآیند بهینه شده کلوخهزدایی تحت عملیات قرار گرفت و سپس هر یک در میدان الکتریکی ۷ ۵۰ رسوب داده شدند.

در نهایت توزیع تخلخل بدنه ها اندازه گیری شد، نتایج در شکل ۹ نشان داده شده است. در تمام نمونه ها دنباله تخلخل های بزرگتر از ۱۰۰ m که ویژگی نمونه های رسوب داده شده در میدان های بالاتر از SL۱۰ ۵۰ است دیده نمی شود. در بار جامد یا ۱۰۰ g/lit (SL۱۰ ) اندازه تخلخل ها بزرگتر شده و اندازه متوسط تخلخل اسه ۱۴۵ nm است. با افزایش بار جامد تا ۱۲۰ و ۱۵۰ g/lit اندازه متوسط تخلخل کاهش یافته و به ترتیب به ۱۰۰ و mm ۵۴ رسیده است. اما با افزایش بیشتر بار جامد سوسپانسیون یعنی است. اما با مجددا اندازه متوسط تخلخل افزایش یافته و به ۱۰۱ nm

ویسکوزیته سوسپانسیون با بار جامد ۱۵۰ ویسکوزیته کمتر از ویسکوزیته سوسپانسیون ۱۸۰ و/۱۳ است. ویسکوزیته کمتر و مقدار مطلوب جامد در دسترس سبب شده است تا ذرات در محدودهای قرار گیرند که در هنگام رسوب در حالت کاملا تعادلی قرار داشته باشد. مقدار رسوب ذرات در حالت source ایشتر از ۱۲۰ و/۱۲ است و این بدین معنا است که در اثر نیروی موجود وزن بیشتری رسوب کرده است و لذا چینش ذرات هنوز در حالت تعادلی است و کمتر از مقداری نیست که تخلخل های کوچک ایجاد کند.

نکته مهم دیگر، اندازه تخلخلهای کوچکتر از ۳۰ m است. در دو نمونه SL۱۲ و SL۱۸ این نوع تخلخلها زیاد شده است و دلیل این امر را در اندازه متوسط تخلخل این دو نمونه می توان جستجو کرد. تقریبا در تمام نمونههایی که اندازه تخلخلی حدود ۳۰ ۱۰۰ دارند (شکل ۸ نمونه ۷۰۱ و شکل ۹ دو نمونه SL۱۲ و SL۱۸ دارند (شکل ۸ نمونه ۱۰۷ و شکل ۹ دو نمونه SL۱۲ و SL۱۸ اخلخلهای کوچکتر از آونهای است که سبب می شود حجم بالایی از تخلخلهای ریز باقی بماند. در نمونه ۲۰۱ و با بار جامد Ir g/lit بار جامد مقدار ذرات جامد در دسترس کم و در نتیجه ویسکوزیته کم است لیکن پایین بودن ویسکوزیته سبب افزایش تحرک ذرات می گردد. در نمونه ۵۰۱ و با بار جامد و با بار جامد از جامد ای م سویانسبون به مدت ۹۰ min سوسیانسبونی با ویسکوزیته rcP بدست آمد که با استفاده از رسو نشانی الكتروفورتيك دريتانسيل الكتريكي ٧ ٥٠ و فاصله بين الکترودهای ۱ cm اندازه تخلخل نمونه بدست آمده به nm ۵۳ nm ر سید.

## مراجع

- [1] H.L. Wen, Y.Y. Chen, F.S. Yen, C.Y. Huang, Nanostructured Materials, 11, 1999, 89.
- W. Zeng, L. Gao, L. Gui, J. Guo, Ceramics International, [2] 25, 1999, 723.
- [3] S.J. Smith, B. Huang, C.H. Bartholomew, B.J. Campbell, J. Boerio-Goates, B.F. Woodfield, The Journal of Physical Chemistry C, 119, 2015, 25053.
- [4] J.G. Li, X. Sun, *Acta Materialia*, 48, 2000, 3103.
  [5] Z.P. Xie, J.W. Lu, Y. Huang, Y.B. Cheng, *Materials* Letters, 57, 2003, 2501.
- [6] M. Mahmoudi, H. Maleki-Ghaleh, M. Kavanlouei, Bulletin of Materials Science, 38, 2015, 351.
- [7] A. Krell, J. Klimke, Journal of the American Ceramic Society, 89, 2006, 1985.
- [8] A. Krell, P. Blank, H. Ma, T. Hutzler, M. Nebelung, Journal of the American Ceramic Society, 86, 2003, 546.
- [9] A. Krell, S. Schadlich, Materials Science and Engineering: A, 307, 2001, 172.
- [10] R. Powers, S. Mitoff, R. King, J. Bielawski, Solid State Ionics, 5, 1981, 287.
- [11] P. Amrollahi, J. Krasinski, R. Vaidyanathan, L. Tayebi, D. Vashaee, "Handbook of Nanoelectrochemistry", Springer International Publishing, 2016.
- [12] N.J. Shaw, R.J. Brook, Journal of the American Ceramic Society, 69, 1986, 107.
- [13] A. Krell, International Journal of Applied Ceramic Technology, 12, 2015, 174.
- [14] J.H. Kennedy, A. Foissy, Journal of The Electrochemical Society, 122, 1975, 482.
- [15] T. Uchikoshi, K. Ozawa, B.D. Hatton, Y. Sakka, Journal Of Materials Research, 16, 2001, 321.
- [16] M. Shan, X. Mao, J. Zhang, S. Wang, Ceramics International, 35, 2009, 1855.
- [17] M. Milani, S.M. Zahraee, S.M. Mirkazemi, Ceramics-Silikaty, 60, 2016, 299.
- [18] A. Braun, G. Falk, R. Clasen, Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, 37, 2006, 293.
- [19] L. Zhang, J. Vleugels, O. Van der Biest, Journal of the European Ceramic Society, 30, 2010, 1195.
- [20] P. Sarkar, P.S. Nicholson, Journal of the American Ceramic Society, 79, 1996, 1987.
- [21] D.R. Brown, F.W. Salt, Journal of Applied Chemistry, 15, 1965, 40.
- [22] A.R. Boccaccini, S. Keim, R. Ma, Y. Li, I. Zhitomirsky, Journal of the Royal Society, Interface/the Royal Society, 7, 2010, 5.
- [23] O. Vande-Biest, L.J. Vandeperre, Annual Review of Materials Science, 29, 1999, 327.
- [24] L. Besra, M. Liu, Progress in Materials Science, 52, 2007,
- [25] H. Hu, Food Hydrocolloids, 30, 2013, 647.
- [26] F. Stenger, W. Peukert, Chemical Engineering and Technology, 26, 2003, 177.
- [27] L. Amaral, P.M. Vilarinho, A.M.R. Senos, Materials

۱۸۰ g/lit نیز ویسکوزیته و ذرات جامد در دسترس بالاست و لذا ذرات بیشتری در واحد زمان به سطح رسوب میرسند. پس آنچه که سبب تشکیل تخلخل های ریز می شود، سرعت بالا و یا حجم بالای ذراتی است که به رسوب اضافه می شوند. در نمونه ۸۰۱ (شکل ۱) نیز همین شرایط به طور همزمان اتفاق افتاده و لذا حجم تخلخل های زیر ۱۰ nm به شدت بالاست. در نمونه ۵۰۲ (شکل ۱) هم که سرعت ذرات کمتر از حد مناسب شده است حجم بالایی از تخلخل های ریز وجود دارد.

بنابراين بهترين شرايط رسوب از نظر توزيع تخلخل نمونهها در بار جامد Jos g/lit و در میدان الکتریکی ۵۰ V/cm محقق می شود مشروط بر آنکه در مرحله ساخت سوسیانسیون از ۱۲۰ s اولتر اسونیک و ۹۰ min پیر سازی محلول با استفاده از همز ن استفاده شود.



شکل ۹: توزیع تخلخل در نمونه های با بار جامد مختلف (۱۰، ۱۲، ۱۵ و ۱۸ آلومینا در ۱۰۰ ml اتانول) بعد از بهینهسازی زمان اولتراسونیک و پیرسازی و در ميدان الكتريكي V/cm.

٤- نتيجه گيري

با استفاده از پراکنده ساز مناسب (ید، ۴۰۰ ppm) و ساخت سوسیانسیون آلومینایی در اتانول و کلوخهزدایی با استفاده از فر آیند اولتراسونیک پرابی به مدت ۱۲۰ و پیرسازی [29] A.A. Sadeghi, T. Ebadzadeh, B. Raissi, S. Ghashghaie, S.M.A. Fateminia, *The Journal of Physical Chemistry B*, **117**, 2013, 1731.

Chemistry and Physics, **149**, 2015, 445. [28] G. Gunkaya, M. Gurbuz, A. Dolan, *Journal of Sensors*, **2015**, 2015, 971473.